

シリコンNPN拡散接合形トランジスタ
SILICON NPN DIFFUSED JUNCTION TRANSISTOR

2SD129
2SD130

○ 電力増幅用

○ Power Amplifier Applications.

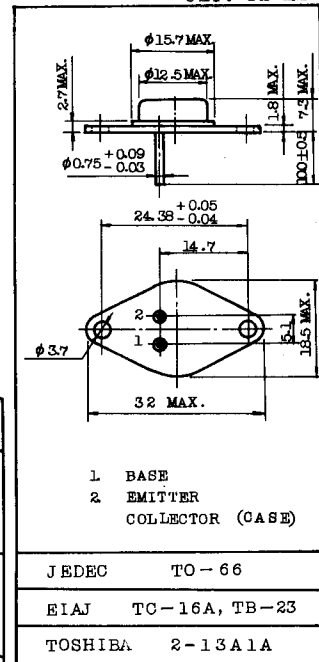
- ・ 高耐圧です： $V_{CEO} = 80V$
- ・ 飽和電圧が低い： $V_{CE(sat)} = 1.5V$ (Max.)
- ・ 許容コレクタ損失が大きい： $P_C = 25W$ ($T_c = 25^\circ C$)
- ・ B級プッシュプル動作で10~20Wの出力が得られます。

10~20W Output in Class B Push-Pull Operation

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SD129	90	V
	2SD180	60	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SD129	80	V
	2SD180	50	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	I_C	8	A
エミッタ電流	I_E	-8	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	25	W
1. 温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

Unit in mm



アクセサリはAC74を適用
MOUNTING KIT No. AC74

電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25 °C)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流		I_{CBO}	$V_{CB} = -50V$ $I_E = 0$	-	-	1	mA
エミッタしや断電流		I_{EBO}	$V_{EB} = 5V$ $I_C = 0$	-	-	1	mA
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SD129	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 100mA$ $I_B = 0$	80	-	-	V
	2SD180			50	-	-	
エミッタ・ベース間降伏電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10mA$ $I_C = 0$	10	-	-	V
直流電流増幅率		(Note) $h_{FE} (1)$	$V_{CE} = 5V$ $I_C = 0.5A$	80	-	200	
直流電流増幅率	2SD129	$h_{FE} (2)$	$V_{CE} = 5V$ $I_C = 2.5A$	10	-	-	
	2SD130			15	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C = 8A$ $I_B = 0.8A$	-	0.4	1.5	V
ベース・エミッタ間電圧		V_{BE}	$I_C = 0.5A$ $V_{CE} = 5V$	-	-	0.9	V
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB} = -10V$ $I_E = 0$ $f = 1MHz$	-	250	-	pF
トランジション周波数		f_T	$V_{CE} = 10V$ $I_E = -0.5A$	-	1	-	MHz

Note ; $h_{FE}(1)$ により下表のように分類し現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE}(1)$, the 2SD129 and 2SD180 are classified as follows.

CLASSIFI- CATION	MIN.	MAX.
2SD129-R 2SD130-R	80	70
2SD129-Y 2SD130-Y	50	120
2SD129-BL 2SD130-BL	85	200